

真空ベーキング装置

■ 用途

真空排気、最高 300℃の加熱処理が自動運転で行えます。

半導体部品・電子電気部品・電子材料などのクリーン乾燥や、ボルトやフランジなどの機械加工品、Oリングなどの表面クリーニングに活躍しています。

金属・セラミックス等の改質、アニール、エージングなど各種ご要望に応じたカスタマイズをご提案いたします。

【導入分野】量産向け生産、研究開発、試作品開発



■ 特徴

高真空排気系、制御系を一体化し、ホットプレート式加熱ヒータを構成したコンパクトな熱処理装置です。

ターボ分子ポンプ、ドライ真空ポンプによる 10^{-5} Pa 台の到達真空圧力を標準仕様とし、クリーンな雰囲気及要求される半導体部品・電子電気部品・電子材料などの処理に対応します。

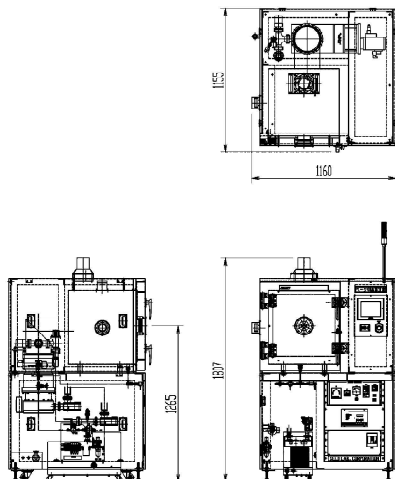
槽内には棚板を設置することができ、小部品の処理量増加、均一な処理を効率的に行うことができます。

お客様の御要望に沿って、雰囲気、ワークステージ、昇温条件にお応えしています。

■ 仕様

真空ベーキング装置

排気性能	到達圧力	$\leq 5.0 \times 10^{-5}$ Pa	制御系	主操作	制御盤 PLC 操作
	排気時間	$\leq 1.0 \times 10^{-4}$ Pa 30 min 以内		自動動作機能	排気系動作 プロセス運転
真空槽	真空槽	SUS チャンバ	オプション	水冷機構	冷却水循環装置
排気系	主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ (空冷)		ベントガス (増設、変更)	Ar 他
	補助ポンプ	ドライ真空ポンプ or 油回転ポンプ	ユーティリティ	電力・接地	主電源系 3φ AC200V 40A 50/60 Hz
	各種バルブ	PLC 操作(自動および手動)		冷却水	供給圧 : 0.2 ~ 0.3 MPa 水温 : 20 ~ 35 °C 水量 : ≥ 5 L/min
真空計	低真空 高真空	ワイドレンジ真空計		ベントガス	窒素ガス 0.1 ~ 0.15 MPa
槽内アクセス	アクセスドア	O リングシール	圧縮空気	0.5 ~ 0.8 MPa	
機能	加熱温度	常用 100~300 °C MAX 350 °C ※MAX 650°C 高温仕様 対応可能	設置面積	(W×D×H) =1200mm×1200mm×2200mm	
	炉内寸法	(W×D×H) =500mm×500mm×500mm			
	試料質量 (SUS 材試料 参考)	下段 : Max 30 kg 棚 : Max 10 kg			



■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場 : 〒252-1125
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27

電話 : 0467-77-4351

FAX : 0467-77-9858

URL : <https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。
2024.11